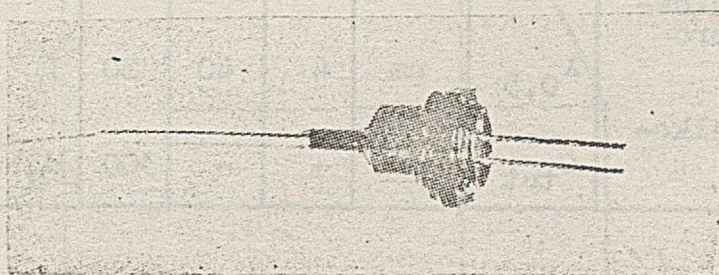
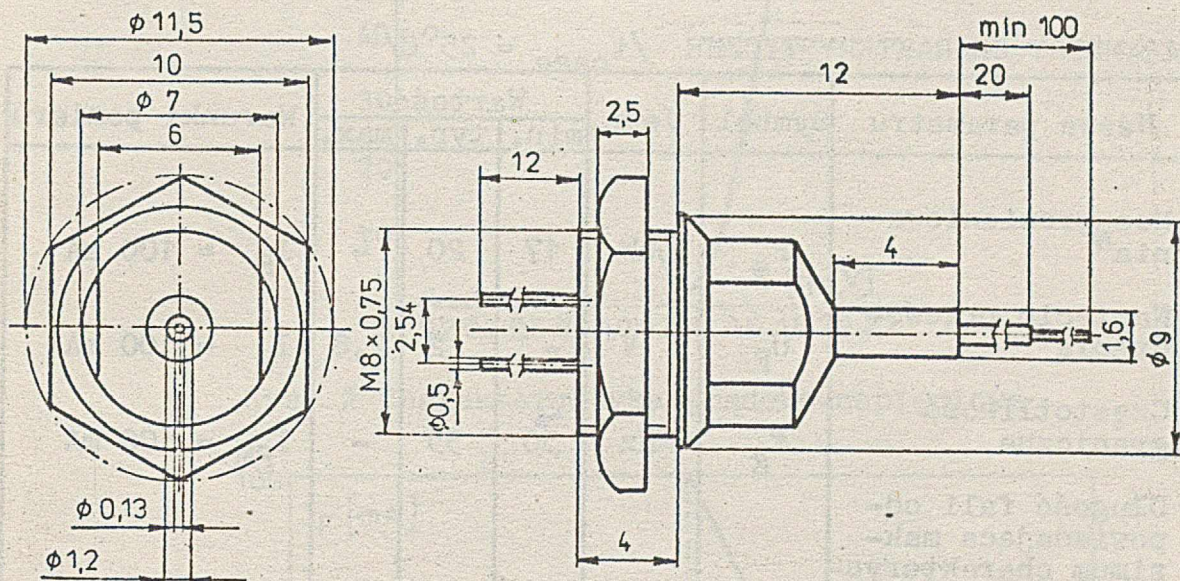


DIODA PODCZERWONA

CQYP 07F

Dioda podczerwona z GaAs/AlGaAs o konstrukcji krawędziowej połączona ze światłowodem telekomunikacyjnym o średnicy rdzenia  $\phi_r = 50 \mu\text{m}$  i aperturze numerycznej  $NA = 0,2$ . Może być stosowana w łączach światłowodowych krótkiego i średniego zasięgu.



Rys. 1 Schemat i fotografia diody CQYP 07F



WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW

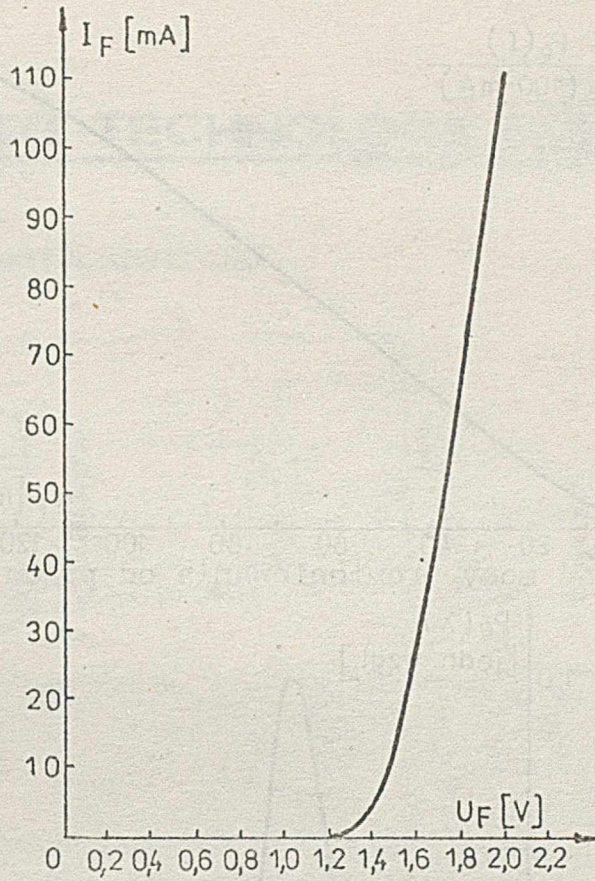
Prąd przewodzenia	$I_F$	100	mA
Napięcie wsteczne	$U_R$	2	V
Temperatura obudowy	$t_{case}$	-40 + +55	°C
Temperatura przechowywania	$t_{str}$	-40 + +70	°C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE / $t_{case} = 25^\circ\text{C}$ /

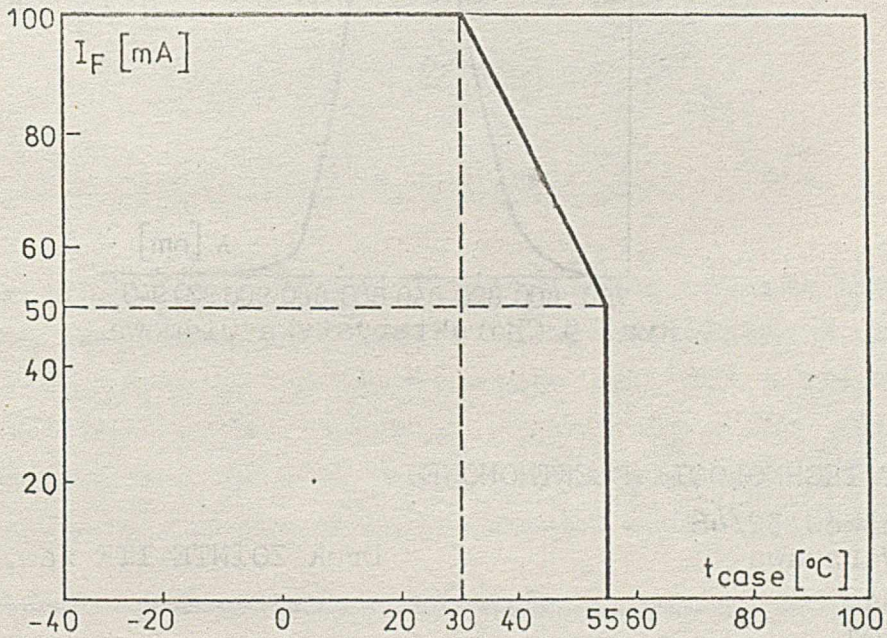
Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru
			min.	typ.	max.	
Moc promieniowania <sup>*)</sup>	$P_e$	$\mu\text{W}$	17	20	-	$I_F = 100 \text{ mA}$
Napięcie przewodzenia	$U_F$	V	-	2	2,8	$I_F = 100 \text{ mA}$
Częstotliwość graniczna	$f_g$	MHz	30	35	-	$I_{FM} = 100 \text{ mA}$
Długość fali odpowiadająca maksimum charakterystyki widmowej	$\lambda_p$	nm	800	835	870	$I_F = 100 \text{ mA}$
Szerokość połówkowa widma promieniowania	$\lambda_{0,5}$	nm	4	40	80	$I_F = 100 \text{ mA}$
Pojemność całkowita	$C_{tot}$	pF	-	-	300	$U_R = 0, f=1 \text{ MHz}$

\*) Moc promieniowania wychodząca ze światłowodu o średnicy rdzenia  $\Phi_r = 50 \mu\text{m}$  i aperturze numerycznej  $NA = 0,2$ .



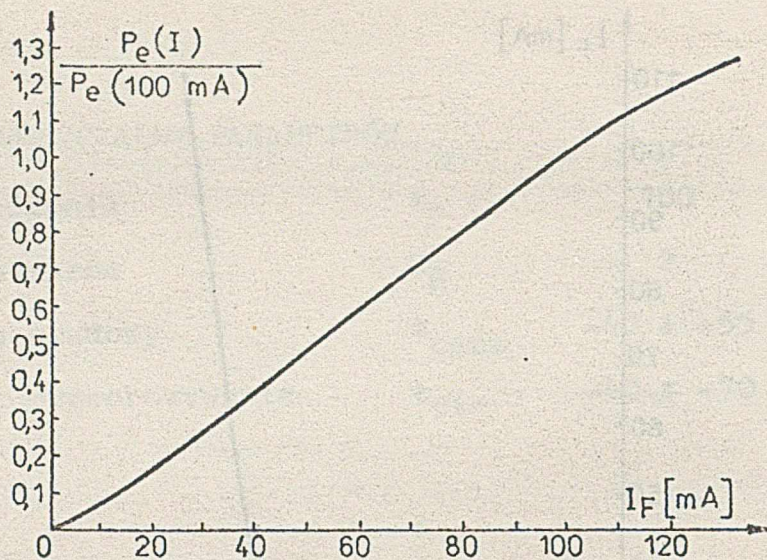


Rys. 2 Charakterystyka prądowo-napięciowa

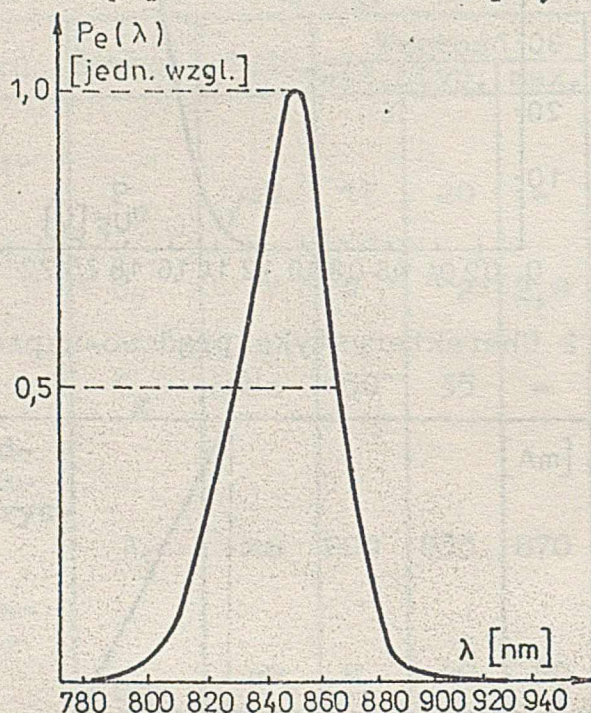


Rys. 3 Zależność dopuszczalnego prądu przewodzenia od temperatury obudowy





Rys. 4 Zależność mocy promieniowania od prądu przewodzenia



Rys. 5 Charakterystyka widmowa

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46  
02-668 Warszawa

Tlx 815647  
Tel. 435401

Maj 1937 r.

Cena 40 zł

Druk ZOINTE ITE zam. 71/37 s. 300

Parametry i obudowa  
mogą ulec zmianie

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE